

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 28 年 3 月 31 日 (2016.3.31)

【公開番号】特開 2014-207256 (P2014-207256A)

【公開日】平成 26 年 10 月 30 日 (2014.10.30)

【年通号数】公開・登録公報 2014-060

【出願番号】特願 2013-82252 (P2013-82252)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/52 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/52 A

【手続補正書】

【提出日】平成 28 年 2 月 10 日 (2016.2.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ダイパッドと、
前記ダイパッドの上に設けられたダイボンディング材と、
下面が前記ダイボンディング材に接触することで前記ダイパッドに固定された半導体チップと、
前記半導体チップの側面のみに形成された撥水性膜と、を備えたことを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】

ダイシングラインで区切られた複数の半導体チップを有するウエハの下面をダイシングテープに付着させ、前記ウエハの上面にダイシング保護膜を付着させる工程と、
前記ウエハと前記ダイシング保護膜をダイシングラインに沿ってダイシングするダイシング工程と、
前記ダイシング工程の後に、前記半導体チップの側面、前記ダイシング保護膜の側面、及び前記ダイシング保護膜の上面に撥水性膜を形成する工程と、
前記ダイシング保護膜を除去する工程と、を備えたことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 3】

前記撥水性膜は C V D 法で形成することを特徴とする請求項 2 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 4】

前記撥水性膜は P V D 法で形成し、
前記撥水性膜を形成する際は、前記撥水性膜となる成分が前記半導体チップの側面に入射するように前記半導体チップを配置することを特徴とする請求項 2 に記載の半導体装置の製造方法。